



Рис. 2. Смещение максимумов полос в спектрах КРС образцов твердого раствора $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ в зависимости от содержания германия (*a* – колебание связи Si—Ge; *b* – колебание связи Ge—Ge; *в* – колебание связи Si—Si; 1 – исходные образцы; 2 – образцы после обработки в водородной плазме)

Fig. 2. Shift of band maxima in the Raman spectra of samples of the $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ solid solution depending on the germanium content (*a* – vibration of the Si—Ge bond; *b* – vibration of the Ge—Ge bond; *c* – vibration of the Si—Si bond; 1 – initial samples; 2 – samples after treatment in hydrogen plasma)